

SOT223 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 4 - OCTOBER 1995

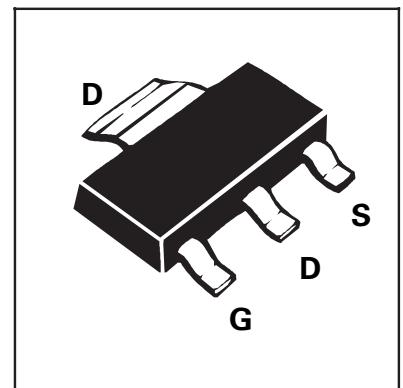
ZVN4424G

FEATURES

- * 240 Volt V_{DS}
- * Extremely low $R_{DS(on)} = 4.3\Omega$
- * Low threshold and Fast switching

APPLICATIONS

- * Earth recall and dialling switches
- * Electronic hook switches
- * Battery powered equipment
- * Telecoms and high voltage dc-dc convertors

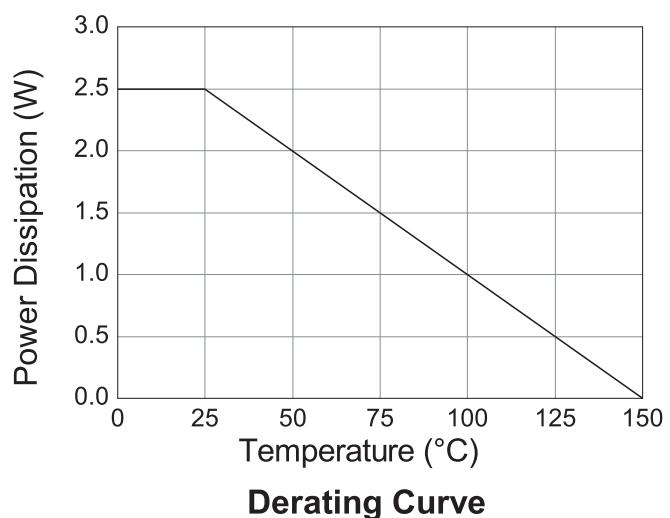
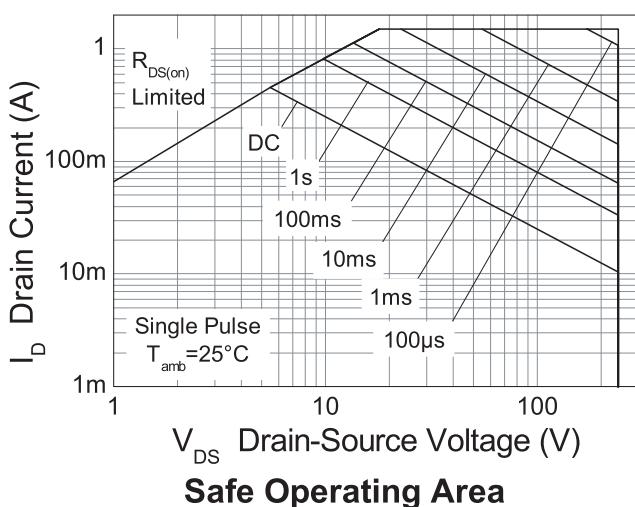


PARTMARKING DETAILS - ZVN4424

COMPLEMENTARY TYPE - ZVP4424G

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	240	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^\circ C$	I_D	500	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	1.5	A
Gate Source Voltage	V_{GS}	± 40	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$	P_{tot}	2.5	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +150	°C



ZVN4424G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

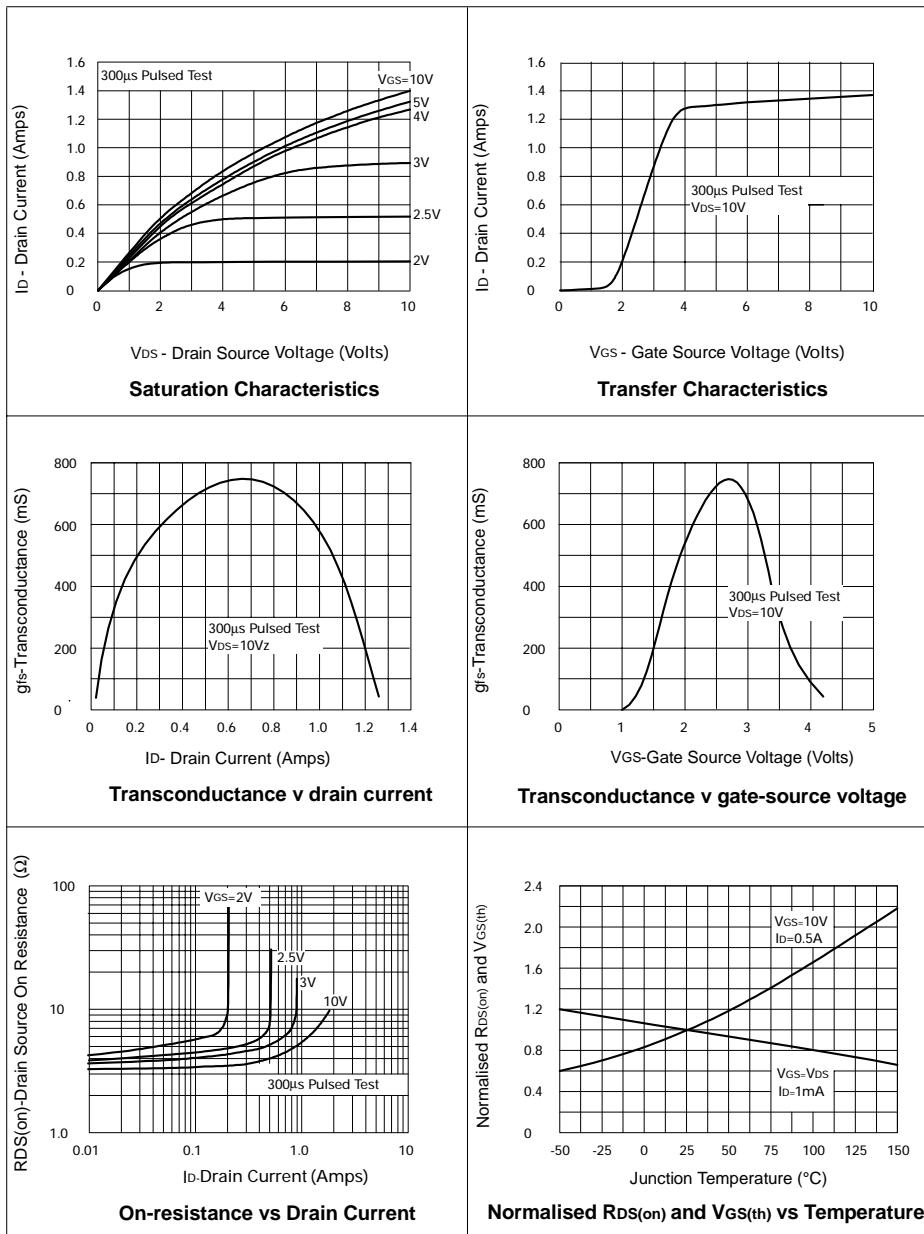
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	240			V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	1.3	1.8	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}			100	nA	$V_{GS}=\pm 40V, V_{DS}=0V$
On State Drain-Current	$I_{D(on)}$	0.8	1.4		A	$V_{DS}=10V, V_{GS}=10V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}			10 100	μA μA	$V_{DS}=240V, V_{GS}=0V$ $V_{DS}=190V, V_{GS}=0V, T=125^\circ C$
Static Drain-Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$		4 4.3	5.5 6	Ω Ω	$V_{GS}=10V, I_D=500mA^*$ $V_{GS}=2.5V, I_D=100mA^*$
Forward Transconductance (1) (2)	g_{fs}	0.4	0.75		S	$V_{DS}=10V, I_D=0.5A$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		110	200	pF	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		15	25	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		3.5	15	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		2.5	5	ns	$V_{DD}=50V, I_D=0.25A, V_{GEN}=10V$
Rise Time (2)(3)	t_r		5	8	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		40	60	ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		16	25	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300μs. Duty cycle ≤2%

(2) Sample test.

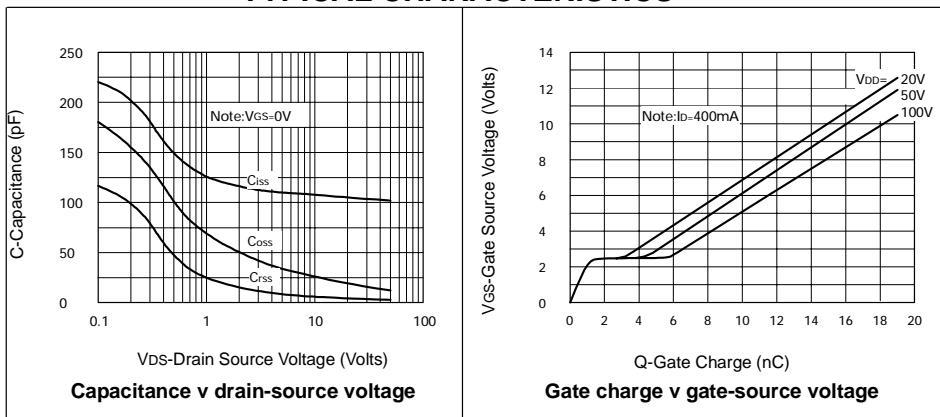
(3) Switching times measured with 50Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator
Spice parameter data is available upon request for this device

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZVN4424G

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9